膨張させるとスピン配列がねじれる磁石の発見

研究の背景

物質中のスピンがらせん状に配列したらせん磁性体は、 スピンのねじれ方を情報として活用する新たなスピントロ ニクス材料となることが期待されている物質群である。た だし、このようならせん磁性を安定化させるためには、特 殊な結晶構造や磁性元素の配置が必要となるため、その種 類は限られてしまう。例えば、らせん磁性によりマルチ フェロイック物質となるペロブスカイト型マンガン酸化物 RMnO3 (R: 希土類元素)では、結晶構造が直方晶へ大き く歪むことにより、最近接以外の Mn スピンとの交換相互 作用が重要となるため、基底状態が単純な反強磁性からら せん磁性へと変化する[1,2]。同様のメカニズムに従い物 質開発を行う場合、このような複雑な結晶構造に起因する 磁気的フラストレーションの制御や設計は容易ではない。 これに対し、AFeO₃(A: アルカリ土類元素)で表されるペ ロブスカイト型鉄酸化物では、単純立方格子にもかかわら ず、多彩ならせん磁性が発現する稀な物質系である。特に、 対称性の高い結晶構造におけるらせん磁性は、磁気スキル ミオンの理想的な舞台となり得るため、近年は革新的なス ピントロニクス応用の観点からも有望視されている。

では、何故 AFeO₃ ではらせん磁性が発現するのか?その起源として、Fe⁴⁺という異常高原子価に由来する鉄 3d 軌道と酸素 2p 軌道の強い混成効果が提唱されている。こ のような状態は負の電荷移動エネルギー状態と呼ばれ、酸 素ホールあるいはリガンドホール描像で記述されるため、 多くの遷移金属酸化物で見られる反強磁性モット絶縁体相 とは異なる新奇な遍歴磁性相が安定化されることが理論的 に予想されている[3,4]。このため本系の磁性は p-d 混成 の強さに非常に敏感であり、単純立方格子を保持したまま A サイトのイオン半径を変化させるだけで、らせん磁性を 大幅に制御できる。実際、SrFeO₃ では、らせん磁性の伝 播ベクトルが<111>方向であるが、BaFeO₃ では伝播ベク トルが<001>方向へ移り変わったらせん磁性が安定となる。

同じく後期遷移金属で Co⁴⁺の異常高原子価状態を有す るペロブスカイト型コバルト酸化物 ACoO₃ も興味深い磁 性を示すことが知られている。SrCoO₃ は、SrFeO₃ と同

¹大阪大学、²国際超強磁場科学研究施設、³東京大学 酒井 英明¹、徳永 将史²、石渡 晋太郎^{3,1}

じ単純立方格子を有するが、室温強磁性体 (Tc=305 K) で あり[5-8]、SrFeO₃ と大きく異なる磁性を示す。またごく 最近では、AサイトをSrよりもイオン半径の小さいCaで 置換した CaCoO₃が直方晶に歪んだ反強磁性体となること が報告され[9,10]、本系でもAサイトに敏感な磁性や格子 構造が明らかとなりつつある。そこで本研究では、これま で未開拓であったAサイトのイオン半径をSrよりも大き い Ba で置換した Sr_{1-x}Ba_xCoO₃を開拓し、らせん磁性を 含む新奇磁気状態を探索することを目的とした[11]。



Fig. 1: 立方晶ペロブスカイト型 $Sr_{1-x}Ba_xCoO_3$ 単結晶の (a) 格子 定数(室温), (b) 飽和磁化(2-4 K)の Ba 置換量(x)依存性。(b) に おける点線は Co^{4+} 中間スピン状態の理論値。(c) 本系の磁気相 図。 $T_c \ \ C T_M$ はそれぞれ強磁性 (FM) 転移温度とらせん磁性 (HM) 転移温度を表す。常磁性 (PM) 相における帯磁率の温度依 存性から見積もったワイス温度 θ も一緒にプロットしている。



Fig. 2: (a) 立方晶ペロブスカイト型 **Sr**_{1-x}**Ba**_x**CoO**₃ 単結晶の磁化 の温度依存性 (0.01 T)。逆三角形印は、らせん磁性秩序のオン セット温度に対応。(b) 同物質の磁化の磁場依存性 (2-4 K)。 **x=0.35** と **x=0.4** では、パルス磁場により約 40 T まで測定を行っ た。挿入図は、中間スピン状態の **Co**⁴⁺の電子配置。**Co** 軌道と酸 素軌道の強い混成によりリガンドホール状態が予想される。

実験結果

本研究で用いた $Sr_{1-x}BaxCoO_3$ 試料は、フローティング ゾーン法と高圧合成法を利用した 2 ステップ法により合 成した単結晶試料である。この 2 ステップ法では、まず 大気中で安定な Co^{3+} を内包する酸素欠損ペロブスカイト $Sr_{1-x}Ba_xCoO_{2.5}$ の大型単結晶をフローティングゾーン法に よって育成した。次に、得られた単結晶を 8 万気圧の超高 圧下での低温酸素アニール処理を行うことで、酸素欠損の ない $Sr_{1-x}BaxCoO_3$ (0 < x < 0.5)の大型単結晶を得ることに 成功した。

Figure 1 (a) に、高圧酸素アニール後の $Sr_{1-x}Ba_xCoO_3$ (0 $\leq x \leq 0.5$)単結晶の格子定数の x (Ba 置換量) 依存性を示す。 各組成の格子定数は、単結晶試料を砕いて測定した粉末 X 線回折から見積もった。x=0から 0.4 までは、xに依らず 室温において立方晶構造が保たれており、xが増加するに つれて格子定数はほぼ線形に増加する。尚、 $x \ge 0.5$ の 単結晶では室温でも酸素が徐々に抜けるため、x=0.5の格 子定数は、 $x \le 0.4$ での直線関係から予想される値よりも わずかに大きな値になったと推察される。

Ba 置換による単調な格子定数の増加に対し、SrCoO3 の強磁性状態は大きく変化する。Figure 2(a)は、Sr_{1-x} Ba_xCoO₃ (0≦x≦0.5) 単結晶の磁化(外部磁場: 0.01 T)の温 度依存性を示す。x=0 では室温近傍であった強磁性転移温 度 Tc が、Ba 置換量の増加に伴って系統的に低下し、 x=0.35 では T_C=176 K となる。さらに低温の T_M~43 K 以 下において、磁化の明瞭な減少が観測された。Ba 置換量 をさらに増加させた x=0.4 では、強磁性転移は完全に消失 し、TM 以下での磁化の減少がより顕著となる。後述する ように、TM がらせん磁性秩序が発達し始める温度に対応 している。一方、x=0.5 では、TM における磁化の減少が 抑制され、カスプ的な異常に変化する。これに加え、TM 以下で生じるゼロ磁場冷却後と磁場中冷却後の磁化曲線の 違い(履歴依存性)がより顕著となるため、スピングラス状 態に変化したものと推察される。以上の磁化の温度変化を まとめた磁気相図を Fig. 1(c)に示す。Ba 置換による格子 定数の増加により、SrCoO3の室温強磁性が著しく抑制さ れ、x=0.35-0.4 を臨界組成として、強磁性とらせん磁性 の相競合状態が形成されている[11]。

Ba 置換による Co4+イオンのスピン状態の変化を明ら かにするために、最低温(2-4 K)において磁化の磁場依 存性を測定し、飽和磁化のx依存性を調べた[Fig.1(b)]。 強磁性を基底状態とする x=0.1-0.3 の試料では、約2T の磁場で磁化は飽和し、その飽和磁化は x に対しほぼ一 定の 2.2-2.5 μB/Co であった。一方、x=0.35 や 0.4 では磁 化の飽和に必要な磁場が急激に増加し、らせん磁性秩序の 発達を示唆している。x=0.35 では約40Tの強磁場で磁化 を飽和させることができ、それより見積もられる飽和磁化 は、x=0.1-0.3 とほぼ同程度の 2.2 µB/Co である(尚、 x=0.4 では 40 T でも磁化は飽和しなかった)。このように、 格子サイズの増大に対し、強磁性転移温度は著しく低下す るものの、Co4+イオンのスピン状態は、SrCoO3と同様に ほぼ中間スピン状態 [S=3/2。Fig. 2(b) 挿入図参照] を保 持していることがわかった。従って本系では、Co-O-Co に働く交換相互作用の強磁性的成分と反強磁性的成分が拮 抗しており、そのバランスが格子サイズ(すなわちバンド 幅)に対して非常に敏感に変化していると推察される。

最後に、x=0.4 における磁気秩序の微視的状態を明らか にするため、本物質の単結晶中性子回折実験の結果を紹介 する。詳細は論文[11] に譲るが、TM以下で変調波数<δδ δ>(δ=0.079)を有する磁気散漫散乱が観測され、約28Åの 長周期らせん磁性秩序が発達していることが示唆された。 実際、この磁気状態は第一原理計算でほぼ定量的に再現す ることができ、立方晶ペロブスカイトのようにシンプルな 結晶構造をもつ酸化物であっても、遷移金属と酸素の間に 生じる強い化学結合を制御することでらせん磁性が生じる ことが実証された。

今後の展開

本研究で見出された Sr_{1-x}Ba_xCoO₃ における格子非整合の らせん磁性秩序は、格子サイズの増大により、Co-O-Co間 にはたらく強磁性的な二重交換相互作用に対し、反強磁性 的な超交換相互作用による利得が大きくなったため生じた と予想されるが、微視的メカニズムの詳細は明らかではな い。今後、単純立方格子上の多軌道系における交換相互作 用とその基底状態の問題として理論研究の進展が期待され る。また、中性子回折実験の半値全幅から予想される磁気 相関長は約 12 Å であり、らせん磁性秩序が最低温でも短 距離である点に関しても、十分な理解には至っていない。 Ba 置換や酸素欠損によるランダムネスが一因とも考えら れるが、強磁性の強い揺らぎ(短距離相関)と競合している 可能性も高い。この意味で、ランダムネスの影響なく格子 サイズを制御できる外部圧力効果は、今後の重要な研究 テーマの一つである。

デバイス応用の観点からは、Sr1-xBaxCoO3 は薄膜基板 上での単結晶成長に適したシンプルな立方晶構造をもつた め、酸化物スピントロニクスへの展開が期待される。また、 本研究で観測された結晶格子の増大による強磁性–らせん 磁性転移は、負の化学圧力による磁性スイッチングと見な すことができ、新たな圧力センサーや磁気アクチュエー ターへの応用も期待できる。

謝辞

本研究は、東京大学の横山翔氏、桑原旦幸氏、有田亮太郎氏、十倉好紀氏、東京大学物性研究所の三宅厚志氏、 ポール・シェラー研究所のJ.S. White 氏、E. Canévet 氏、 スイス連邦工科大の H. M. Rønnow 氏、東北大学の是常隆氏、の協力のもと行われた。

参考文献

- [1] T. Kimura et al., Nature 426, 55 (2003).
- [2] M. Kenzelmann et al., Phys. Rev. Lett. 95, 087206 (2005).
- [3] M. Azhar and M. Mostovoy, Phys. Rev. Lett. 118, 027203(2017).
- [4] M. Mostovoy, Phys. Rev. Lett. 94, 137205 (2005).
- [5] P. Bezdicka et al., Z. anorg. allg. Chem. 619, 7 (1993).
- [6] M. Abbate et al., Phys. Rev. B 65, 165120 (2002).
- [7] S. Balamurugan et al., Phys. Rev. B 74, 172406 (2006).
- [8] Y. Long et al., J. Phys.: Condens. Matter 23, 24601 (2011).
- [9] H. Xia et al., Phys. Rev. Materials 1, 024406 (2017).
- [10] T. Osaka et al., Phys. Rev. B 95, 224440 (2017).
- [11] H. Sakai et al., Phys. Rev. Mater. 2, 104412 (2018).